

MOS形電界効果パワー トランジスタ
MOS Field Effect Power Transistor

2SJ137

Pチャンネルパワー-MOS FET
スイッチング用
工業用

2SJ137は、Pチャンネル縦形パワー-MOS FETで、5V電源系ICの出力による直接駆動が可能な高速スイッチングデバイスです。

オン抵抗が低く、スイッチング特性も優れているため、モータ、ソレノイド、ランプの制御に最適です。

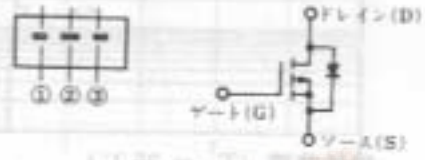
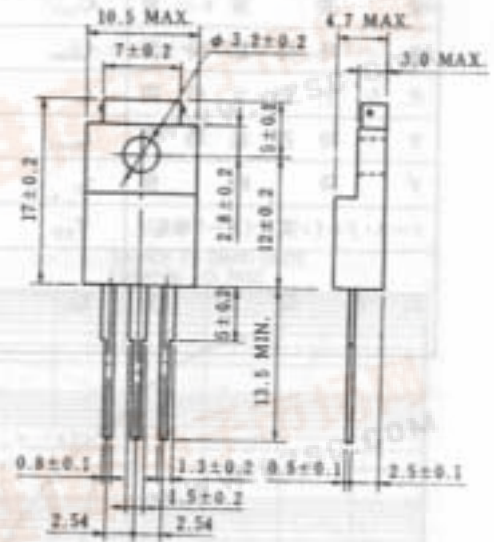
特 徴

- 低オン抵抗です。
 $R_{DS(on)} \leq 0.3 \Omega$ @ $V_{GS} = -10V, I_D = -6.5A$
 $R_{DS(on)} \leq 0.5 \Omega$ @ $V_{GS} = -4V, I_D = -4.0A$
- 4V駆動です。
- インダクティブ負荷において保護回路なしで動作が可能です。

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ C$)

項 目	略 号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DS}	$V_{GS} = 0$	-60	V
ゲート・ソース間電圧	V_{GS}	$V_{DS} = 0$	± 20	V
ドレイン電流(直流)	$I_{D(DC)}$	$T_C = 25^\circ C$	± 10	A
ドレイン電流(パルス)	$I_{D(max)}$	$PW \leq 100\mu s$ $Duty\ Cycle \leq 2\%$	± 40	A
全 損 失	P_T	$T_C = 25^\circ C$	30	W
全 損 失	P_T	$T_a = 25^\circ C$	2.0	W
チャネル温度	T_{ch}		150	$^\circ C$
保 存 温 度	T_{stg}		-55 ~ +150	$^\circ C$

外形図 (単位: mm)



電極接続
① Gate
② Drain
③ Source

(上図中のダイオードは寄生ダイオードです。)

2SJ137

MOS Field Effect Power Transistor
電氣的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
ドレインシャ断電流	I_{DSS}	$V_{DS} = -60\text{V}, V_{GS} = 0$			-10	μA
ゲート漏れ電流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20\text{V}, V_{DS} = 0$			± 100	nA
ゲートカットオフ電圧	$V_{GS(off)}$	$V_{DS} = -10\text{V}, I_D = -1.0\text{mA}$	-1.0	-2.0	-3.0	V
順伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS} = -10\text{V}, I_D = -6.5\text{A}$	2.0	5.0		S
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10\text{V}, I_D = -6.5\text{A}$		0.25	0.3	Ω
ドレイン・ソース間オン抵抗	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.0\text{V}, I_D = -4.0\text{A}$		0.4	0.5	Ω
入 力 容 量	C_{iss}	$V_{DS} = -10\text{V}$		1500		pF
出 力 容 量	C_{oss}	$V_{GS} = 0\text{V}$		450		pF
掃 過 容 量	C_{rss}	$f = 1.0\text{MHz}$		80		pF
オン時遅延時間	$t_{d(on)}$	$I_D = -6.5\text{A}, V_{GS(on)} = -10\text{V}$		15		ns
立ち上がり時間	t_r	$V_{DD} = -30\text{V}, R_L = 5\Omega$		55		ns
オフ時遅延時間	$t_{d(off)}$	$R_{on} = 10\Omega$		45		ns
下 降 時 間	t_f	測定回路図1参照		120		ns
ソース・ドレイン間ダイオード順電圧	V_{SD}	$I_{SD} = -10\text{A}, V_{GS} = 0$		0.9		V
L 負 荷 耐 量	I_{DL}	$V_{DD} = -30\text{V}, V_{GS(off)} = 0$ $L \leq 100\mu\text{H}, R_C \geq 100\Omega$ Unclamped 測定回路図2参照			-10	A

特性曲線 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

